

**关键指标**

频率: 2.2~4.2GHz  
 小信号增益: 26.5dB  
 1dB 压缩点输出功率: 26dBm  
 3dB 压缩点输出功率: 27dBm  
 电压/静态电流: +5V/370mA  
 芯片尺寸: 2.6mm×1.5mm

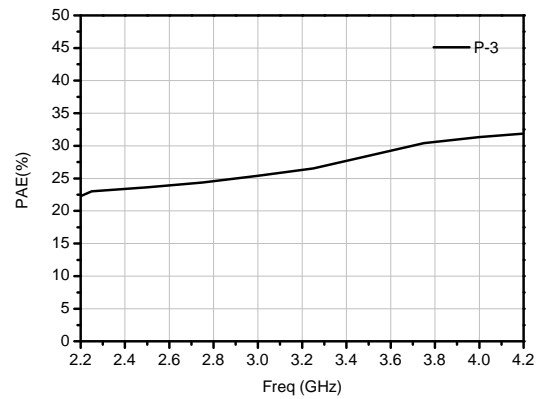
**产品简介**

HG123F4 驱动放大器芯片, 采用 GaAs pHEMT 工艺制作, 单电源供电, 输入输出端均集成有隔直电容。

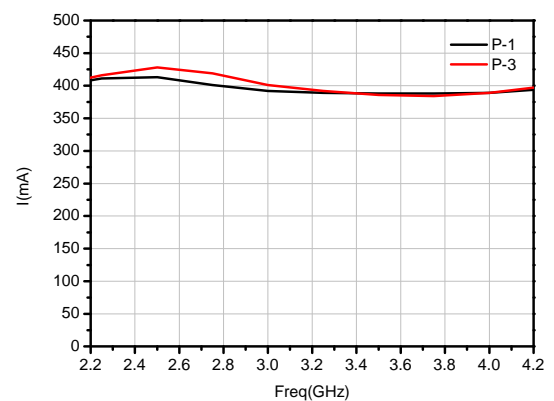
**电性能 (T<sub>A</sub>=25°C, V<sub>dd</sub>=+5V)**

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	2.2~4.2		
增益(dB)	-	26.5	-
输入驻波	-	1.2	-
输出驻波	-	1.3	-
1dB 压缩点输出功率 (dBm)	-	26	-
3dB 压缩点输出功率 (dBm)	-	27	-
功率附加效率 (%)	-	28	-
静态电流 (mA)	-	370	-

功率附加效率

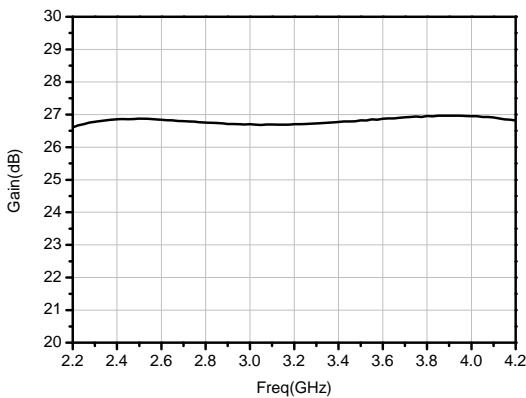


工作电流

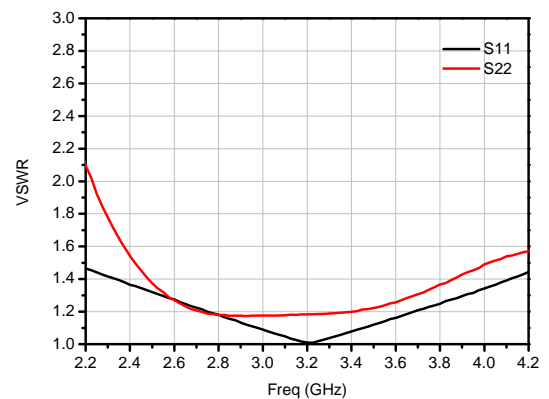


**典型测试曲线**

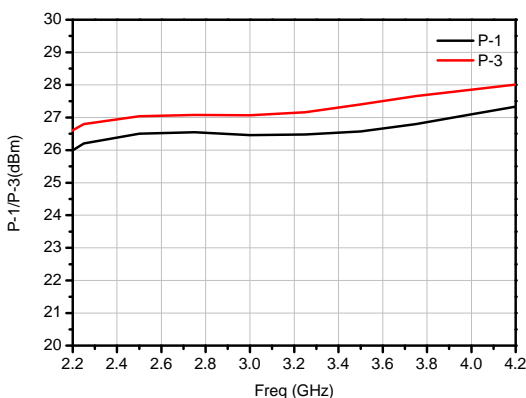
小信号增益



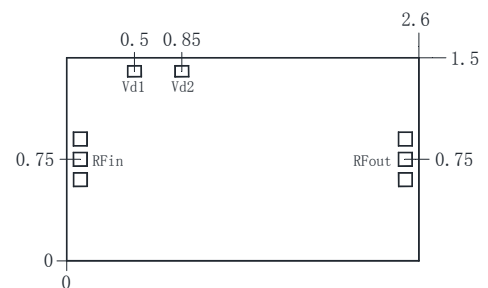
驻波



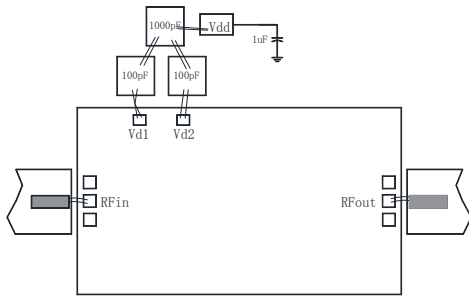
1dB/3dB 压缩点输出功率



**外形和端口尺寸 (mm)**



推荐装配图



绝对额定最大值

工作电压	+7V
最大输入功率	+18dBm
工作温度	-55°C~125°C
存储温度	-65°C~150°C

注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储，在超净环境使用；
2. GaAs 材料较脆，不能触碰芯片表面，使用时必须小心；
3. 芯片用合金烧结（合金温度不能超过 300°C，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm，使用  $\Phi 25\mu\text{m}$  双金丝键合，建议金丝长度 250~400 $\mu\text{m}$ ；
5. 芯片微波端有隔直电容；
6. 芯片对静电敏感，在储存和使用过程中注意防静电。